

Silicon Diode

BY195

Fast Rectifier

800V / 4A

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

BY 192...BY 195

Kennwerte

| | | | |
|---|-----------|------|---------------|
| Nennstrom in Einwegschaltung mit Widerstandslast bei $T_G = 25\text{ °C}$ | I_{FAV} | 4 | A |
| Durchlaßspannung bei $I_F = 3\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$ | u_F | <1,3 | V |
| Sperrstrom bei U_{RRM} , $T_j = 25\text{ °C}$ | I_R | <10 | μA |
| Durchlaßverzögerung bei $I_F = 100\text{ mA}$ | t_{fr} | <1 | μs |
| Sperrverzögerung bei $T_G = 25\text{ °C}$ beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$ | t_{rr} | <0,5 | μs |
| Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse | R_{thG} | <5 | K/W |